

от H : ян-тэллеровские корреляции приводят к отталкиванию уровней вблизи точки их возможного (при $\bar{S}_z=0$) пересечения.

3. Таким образом, в системах антиферротипа с конкурирующими взаимодействиями может существовать в поле фаза, где реализованы оба упорядочения. Удобным объектом, где можно было бы наблюдать магнито-дисторсионную фазу, представляется изинговские антиферромагнетики типа HoPO_4 , HoAsO_4 . Совместное исследование их магнитных и упругих свойств, аналогичное проведенному недавно для CePb_3 [7] и позволившее обнаружить в нем неизвестную ранее фазу, представляется поэтому весьма интересным.

Л и т е р а т у р а

- [1] Vekhter B. G., Kaplan M. D. Phys. Lett., 1973, vol. 43A, N 3, p. 389—390.
- [2] Cook U., Swithenby S. J., Wells M. R. Sol. St. Commun., 1972, vol. 10, N 2, p. 265—267.
- [3] Laugsch J., Kahle H. C., Schwab M., Wuchner W. Physica B, 1975, vol. 80, N 2, p. 269—286.
- [4] Булаевский Л. И., Вехтер Б. Г. ЖЭТФ, 1986, т. 91, № 4 (10), с. 1444—1453.
- [5] Вонсовский С. В. Магнетизм. М.: Наука, 1971. 1032 с.
- [6] Gehring G. A., Gehring K. A. Rep. Prog. Phys., 1975, vol. 38, N 1, p. 1—89.
- [7] Nikl D., Kouroudis I., Assmus W., Luthi B., Bruls G., Welp U. Phys. Rev., 1987, vol. B35, N 13, p. 6864—6867.

Институт химии АН МССР
Кишинев

Поступило в Редакцию
9 ноября 1987 г.

УДК 537.311

Физика твердого тела, том 30, в. 4, 1988
Solid State Physics, vol. 30, № 4, 1988

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ГИБРИДИЗОВАННЫХ f -ЭЛЕКТРОНОВ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНОГО ВЫРОЖДЕНИЯ f -ОБОЛОЧЕК

Ю. П. Ирхин

Гибридизация f -электронов с электронами проводимости является одним из основных эффектов в редкоземельных (РЗ) и урановых соединениях с промежуточной валентностью и с тяжелыми фермионами. При этом важную роль играет величина параметра гибридизации V , который вместе с параметрами ϵ_f (энергия f -электрона) и ϵ_F (энергия Ферми) определяет области существования различных возможных режимов (промежуточная валентность, резонанс Абрикосова—Сула, магнитное упорядочение).

В теоретических моделях V обычно рассматривается как феноменологический параметр, однако этого недостаточно, например, для исследования зависимости эффекта гибридизации от номера редкоземельного элемента и для перехода к количественным расчетам. Существенную роль при этом играет вырождение соответствующих конфигураций f^n и f^{n-1} , сильно меняющееся в РЗ ряде. Так, степень вырождения v весьма важна для определения положения ϵ_F относительно вершины пика f -полосы (или резонанса Абрикосова—Сула) ϵ_0 . Практически большие наблюдаемые значения электронной теплоемкости (или эффективной массы для тяжелых фермионов) могут быть получены в теории только при $\epsilon_f=\epsilon_0$ (см. обсуждение этой проблемы для UBe_{13} в обзоре [1]), что осуществляется при величине $v=2$, которое, как правило, не соответствует реально имеющемуся вырождению. Вторым примером существенного влияния степени вырождения является число Вильсона $R=(\chi T/c)(\pi k_B/\mu_B^2)/3$ (χ — парамагнитная восприимчивость, c — электронная теплоемкость).

R меняется от 2 до 1 ($R=(1-1/\nu)^{-1}$) при изменении числа ν от 2 до ∞ . Отсюда видна актуальность рассмотрения модели sf -гибридизации с учетом реальной структуры f -оболочки.

Запишем гамильтониан f -металла в представлении многоэлектронных квантовых чисел конфигурации $f^n \Gamma_n \equiv (SLJ\mu)_n$. Используя операторы перехода $X(\Gamma\Gamma')$, в стандартных обозначениях имеем

$$\mathcal{H} = \sum_{k\sigma} \epsilon_{k\sigma} a_{k\sigma}^+ a_{k\sigma} + \sum_{i \in \Gamma_n} E(\Gamma_n) X_i(\Gamma_n) + \sum_{i \in \Gamma_n \Gamma_{n-1} k\sigma} [V_i(\Gamma_n, \Gamma_{n-1} k\sigma) \times \\ \times X_i(\Gamma_n \Gamma_{n-1}) a_{k\sigma} + \text{с. с.}] . \quad (1)$$

Выражение (1) является обобщением обычной невырожденной sf -модели [2] на случай реальных f -оболочек.

На основе техники Рака [3] можно вычислить зависимость V_i от чисел Γ_n, Γ_{n-1} в явном виде через $9j$ -символ

$$V_i(\Gamma_n, \Gamma_{n-1} k\sigma) = \Phi(\Gamma_n \Gamma_{n-1}) v_i(\gamma, k\sigma), \quad \Phi = (n [\Gamma_n] [J_{n-1}])^{1/2} \left\{ \begin{array}{ccc} S_n & L_n & J_n \\ S_{n-1} & L_{n-1} & J_{n-1} \\ 1/2 & l & j \end{array} \right\} G_{\Gamma_{n-1}}^{\Gamma_n}, \quad (2)$$

где v — одноэлектронный параметр гибридизации, $\gamma = (lm\sigma)$ — одноэлектронные квантовые числа, $[a] = 2a + 1$, $G_{\Gamma_{n-1}}^{\Gamma_n}$ — генеалогический коэффициент Рака, $j = l \pm 1/2$.

Если считать, что $v(\gamma, k\sigma)$ примерно одинаково для всех РЗ элементов (на этом же предположении основывается формула Дежана для обменного взаимодействия), то функция Φ дает зависимость V от номера РЗ элемента. Для основных термов SL ($J=L-S$ при $1 \leq n \leq 7$ и $J=L+S$ при $8 \leq n \leq 14$) имеем, вычисляя $9j$ -символ с помощью формул [4] для $l=3$, значения Φ , представленные в таблице.

Значения функции $(\Phi_j)^2$ для редкоземельного ряда

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$(\Phi_{5/2})^2$	1	2.25	2.3	1.8	0.9	0.15	0	1.6	2.3	4.1	1.7	0.9	0.3	0
$(\Phi_{7/2})^2$	0	0.25	0.6	0.8	0.63	0	0.9	0.5	1.3	4.1	3.0	3.3	2.8	1

Видно, что гибридизация идет по двум каналам — $j=5/2, 7/2$ и сильно зависит от конфигурации f^n с обращением в нуль для $n=1, 6, 7, 14$ одного из каналов. Последнее отражает существование правил отбора по полным квантовым числам f -оболочки при гибридизации.

Рассмотрим теперь спектр квазичастиц на основе гамильтониана (1). Уравнение для функции Грина G при расцеплении во втором порядке по V имеет вид ($\bar{\varphi} = \bar{\varphi}(\Gamma_n \Gamma_{n-1}) = \overline{X(\Gamma_n)} + \overline{X(\Gamma_{n-1})}$)

$$\left[E - \epsilon_f(\Gamma_n \Gamma_{n-1}) - \bar{\varphi} \sum_{\sigma} |V|^2 (E - \epsilon_{k\sigma})^{-1} \right] G_{E, k}(\Gamma_{n-1} \Gamma_n | \Gamma'_n \Gamma'_{n-1}) = \frac{\delta_{\Gamma\Gamma'}}{2\pi} \bar{\varphi}. \quad (3)$$

(3) отличается от обычной формой множителями $\bar{\varphi}$, появившимися из-за особых (нефермиевских) коммутационных соотношений для X -операторов, образующих алгебру Ли. Это приводит к важным изменениям в результатах, следующих из (3). Спектр и плотность состояний зависят теперь от средних чисел заполнения $\overline{X(\Gamma_n)}$ («мягкая» полоса). Последние находятся самосогласованным образом

$$\overline{X(\Gamma_n)} = i \lim_{s \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} dE f(E) [G_{E+i s}(\bar{\varphi}) - G_{E-i s}(\bar{\varphi})] \quad (4)$$

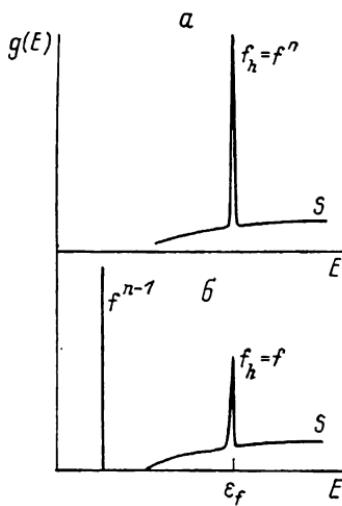
с добавочными условиями (\bar{n} — среднее число электронов на атом)

$$\sum_{n \Gamma_n} \overline{X(\Gamma_n)} = 1, \quad (5)$$

$$\sum_{n \Gamma_n} n \overline{X(\Gamma_n)} = \bar{n}, \quad (6)$$

так что уравнения (4)–(6) образуют полную систему для определения $\overline{X(\Gamma_n)}$ и химпотенциала.

Условие (5) получается путем усреднения по N узлам i соотношения



$$\sum_{n \Gamma_n} X_i(\Gamma_n) = 1,$$

соответствующего тому, что данный узел может находиться одновременно только в одном из возможных состояний Γ_n .

Аналогичное (5) условие должно иметь место и в k -пространстве, поскольку

$$N^{-1} \sum_k X_k(\Gamma_n) = \overline{X(\Gamma_n)}. \quad (7)$$

Плотность состояний $g(E)$ в одноэлектронной (а) и многоэлектронной (б) схемах.

Емкость пика f^n в а равна 14; в б емкость гибридизованной части f -состояний f_h только 1, остальные состояния лежат в конфигурациях $f^{n\pm 1}$, $f^{n\pm 2}$ и т. д.

Рассмотрим теперь вырожденный по проекциям μ_n состояния Γ_n случай, когда $\overline{X(\Gamma_n)}$ не зависит от μ_n . Тогда вместо (5) имеем

$$\sum_n \overline{X(\Gamma_n)} = v^{-1}, \quad (8)$$

и из (7) получаем

$$N^{-1} \sum_{n k} X_k(\Gamma_n) = v^{-1}. \quad (9)$$

Из (9) следует, что число состояний в подполосе $\mu_n(\Gamma_n)$ есть v^{-1} на атом (при $X_k(\Gamma_n) = 1$, $X_k(n' \neq n) = 0$ для всех k), а число состояний во всей вырожденной полосе Γ_n (со всеми μ_n) есть 1.

Этот результат противоположен имеющему место в зонной теории, где в каждой подполосе может поместиться 1 электрон, а во всей полосе v электронов. Различие связано с тем, что в зонной схеме (без учета корреляции) допускается заполнение всех вырожденных состояний на одном узле (т. е. для f -электронов всех 14 состояний), соответствующих всем конфигурациям f^n . В многоэлектронной схеме вырождение по n снято, а из всех v вырожденных состояний Γ_n осуществляется только одно на каждом узле. Учет возможности заполнения других вырожденных состояний μ'_n с $\mu'_n \neq \mu_n$ на одном узле фактически означает учет состояний, принадлежащих другим конфигурациям n' и лежащих в других энергетических интервалах. В этом отношении картина аналогична модели Хаббарда.

При гибридизации двух конфигураций f^n и f^{n-1} множители $\phi(\Gamma_n \Gamma_{n-1})$ регулируют распределение состояний по этим конфигурациям.

Различие одно- и многоэлектронного подходов проиллюстрировано на рисунке. Рисунок, а соответствует обычным зонным расчетам [5, 6]. Видно (см. рисунок, б), как сильное внутриатомное взаимодействие снижает вырождение между конфигурациями f^n и f^{n-1} с соответствующим

распределением полного числа состояний между ними. По-видимому, и в зонной теории можно получить спектр типа *b* при последовательной реализации двухконфигурационного приближения.

Л и т е р а т у р а

- [1] Мощалков В. В., Брандт Н. Б. УФН, 1986, т. 149, № 4, с. 585—634.
- [2] Ирхин Ю. П. Письма в ЖЭТФ, 1980, т. 33, № 3, с. 205—209.
- [3] Собельман И. И. Введение в теорию атомных спектров. М.: Физматгиз, 1963. 640 с.
- [4] Варшалович Д. А., Москалев А. Н., Херсонский В. К. Квантовая теория углового момента. Л.: Наука, 1975. 440 с.
- [5] Farberovich O. V., Nizhnikova G. P., Vlasov S. V., Domashevskaya E. P. Phys. St. Sol. (b), 1984, vol. 121, N 1, p. 241—247.
- [6] Jansen H. J. F., Freeman A. J., Monnier R. Phys. Rev., 1985, vol. B 31, N 6, p. 4092—4095.

Институт физики металлов
УрО АН СССР
Свердловск

Поступило в Редакцию
9 ноября 1987 г.

УДК 536.311.33

Физика твердого тела, том 30, с. 4, 1988
Solid State Physics, vol. 30, № 4, 1988

АНОМАЛИИ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ КРЕМНИЯ С ПРИМЕСЬЮ НИКЕЛЯ

Х. Т. Игамбердыев, А. Т. Мамадалимов, К. Махмудов,
Ш. О. Турсунов, П. К. Хабибуллаев

Исследования физических свойств кристаллов кремния, легированного примесными атомами с глубокими энергетическими уровнями, актуальны в связи с широким применением этих кристаллов в практике. В ряде работ сообщаются противоречивые сведения о температурном поведении физических характеристик таких кристаллов, в частности

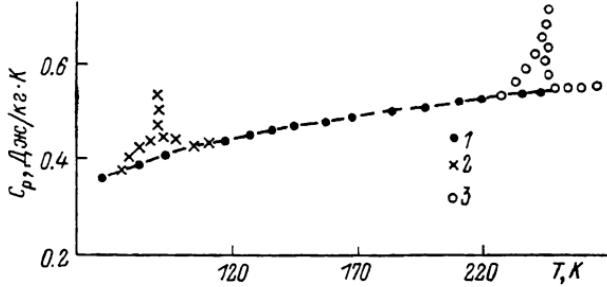


Рис. 1. Теплоемкость кремния с примесью никеля.

1 — Si, 2 — *p*-Si (Ni), 3 — *n*-Si (Ni).

в интервале температур 60—300 К обнаружены ряд аномалий физических свойств, наличие которых связывается с возможным фазовым переходом, индуцированным вводимой примесью [1].

В настоящей работе сообщаются первые результаты исследований температурной зависимости теплоемкости $C_p(T)$ кремния, легированного никелем. Использованы исходные монокристаллические образцы кремния *n*- и *p*-типа. Технология диффузионного легирования кремния никелем, контроль параметров легированных образцов подробно приведены в [2], отметим лишь, что с целью исследования концентрационной зависимости теплоемкости диффузия никеля в кремний проводилась в интервале температур 1300—1550 К. Исследования $C_p(T)$ проводились как с использованием вакуумно-адиабатического калориметра, так и методом сканирующего дифференциального калориметра.